



SiC半導体向け真空炉 6インチ基板に対応

大 学 院 西 関
な

関西学院大学はエピック
エスト(京都市南区、前
野弘志社長、075・6
93・3356)、サン
リック(東京都大田区、

吉岡隆社長、03・37
90・0061)と共同
で、製造プロセスに高温
環境が求められる炭化ケ
イ素(SiC)半導体用

の面積高温真空炉を開
発した。6インチ(約150
ミリ)径の基板に対応す
る。優れた電力変換特性
を持ちパワー半導体とし



て期待されるSiC半導
体の、大面積基板化によ
る低コスト化に役立つと
見られる。

同真空炉は加熱室、ス
トック室、導入室、分析
室で構成される。全室を
高真空にでき高真空中で
の試料搬送が可能。最高
加熱温度は2200度C
で、1000度から20

00度Cまで1分以内に
急速昇温できる。独自の
温度制御方法開発や抵抗
加熱による金属反射板の
最適配置によって実現し
た。

開発した炉は、エピック
エストが早ければ4月中
にも販売する予定。予定
価格は2億5000万
円。